



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, INOVAÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS**

CONSULTA PÚBLICA Nº 25 - SEI, 01 DE AGOSTO DE 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 56, de 03 de maio de 2024, torna pública a proposta de **alteração** do Processo Produtivo Básico – PPB de **COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS**, industrializados no País e na Zona Franca de Manaus

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria, no endereço: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/novo-portal/consultas-publicas>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cgia@mcti.gov.br, cgttd@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br.

UALLACE MOREIRA LIMA

Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços

ANEXO

PROPOSTA N° 60/2024 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, INDUSTRIALIZADOS NO PAÍS E NA ZONA FRANCA DE MANAUS, ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS SEPEC/ME/SEXEC/MCTI N° 5.707 E N° 5.708, DE 8 DE JUNHO DE 2021, RESPECTIVAMENTE.

OBS: Introduz novos art. 5º e 6º mantendo-se, renumerando-se e ajustando-se o que for necessário nos demais artigos. Os §§ 7º e 8º do art. 5º valem somente para a versão de minuta de portaria referente à legislação da Zona Franca de Manaus.

Art. 5º O Processo Produtivo Básico aplicável ao produto denominado MÓDULO DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADO, DO TIPO CAMM (*Compression Attached Memory Module*), LPCAMM (*LowPower Compression Attached Memory Module*), CAMM2, LPCAMM2, e suas versões subsequentes, passa a ser o seguinte:

- I - corte da lâmina (*wafer*);
- II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (*die*);
- III - soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;
- IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (*Ball Grid Array*) ou FBGA (*Fine Ball Grid Array*), quando aplicável;
- VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (*Thin Small-Outline Packages*) ou similar, quando aplicável;
- VII - corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII - testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterização;
- IX - marcação (identificação);
- X - montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;
- XI - gravação da memória do tipo *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory* - EEPROM ou do circuito integrado controlador, quando aplicável; e
- XII - testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificação dos módulos, quando aplicável.

§ 1º As etapas constantes dos incisos I a XI deste artigo poderão ser dispensadas em até 2% (dois por cento) do total de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS, DO TIPO CAMM (*Compression Attached Memory Module*), LPCAMM (*Low-Power Compression Attached Memory Module*), CAMM2, LPCAMM2, e suas versões subsequentes, produzidos conforme o PPB no ano-calendário.

§ 2º Para circuitos integrados monolíticos utilizados nos módulos de memórias, a que se refere o *caput* deste artigo, do tipo memória de acesso aleatório (*Random Access Memory – RAM*) do tipo *Double Data Rate* de quinta geração ou superior (DDR5) ou *Double Data Rate* de baixo consumo de energia de quinta geração ou superior (LPDDR5), poderá ser dispensado o cumprimento das etapas descritas nos incisos de I a IX deste artigo, de acordo com os percentuais e cronograma abaixo, em relação ao total desses circuitos integrados produzidos no ano-calendário:

- I - 2025 a 2027: 100% (cem por cento);
- II - 2028: 80% (oitenta por cento);
- III - 2029: 50% (cinquenta por cento); e
- IV - 2030 em diante: 20% (vinte por cento).

§ 3º Caso os percentuais obrigatórios e complementares aos citados nos §§ 1º e 2º deste artigo não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano imediatamente subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 4º A diferença residual a que se refere o § 3º deste artigo não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomndo-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 5º As etapas constantes dos incisos de I a IX deste artigo não se aplicam às memórias do tipo EEPROM, EPROM, ROM, PROM e Flash RAM ou ao circuito integrado controlador.

§ 6º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS, DO TIPO CAMM (*Compression Attached Memory Module*), LPCAMM (*LowPower Compression Attached Memory Module*), CAMM2, LPCAMM2, e suas versões subsequentes poderão ser realizadas por terceiros, exceto as etapas constantes dos incisos X, XI e XII deste artigo, que não poderão ser objeto de terceirização.

§ 7º As etapas constantes dos incisos X, XI e XII deste artigo deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, podendo as demais serem realizadas em outras regiões do País.

§ 8º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto as etapas descrita no incisos X, XI e XII deste artigo, que não poderão ser objeto de terceirização.

Art. 6º Os requisitos previstos nos arts. 4º e 5º desta Portaria são independentes, deverão ser considerados isoladamente e não poderão ser tomados em conjunto para o cumprimento do PPB, seja para fins de apuração do atingimento dos percentuais mínimos estabelecidos para o respectivo PPB ou para a compensação de diferenças residuais compensáveis, em unidades produzidas, no ano-calendário imediatamente subsequente, observados os limites estabelecidos nesta Portaria.